ADHESIVE METAL SHEET FOR FIXING SEMICONDUCTOR WAFER

Patent number:

JP60196956

Publication date:

1985-10-05

Inventor:

UEMURA TAKEMASA; others: 02

Applicant:

Classification:

- international:

european:Application number:

H01L21/78

JP19840047743 19840312

NITTO DENKI KOGYO KK

Priority number(s):

Also published as:

EP0157508 (A2) EP0157508 (A3)

EP0157508 (B1)

Abstract of JP60196956

PURPOSE:To offer adhesive metal sheet which is able to use also when the size of small piece of element is above 50mm.<2>, by a method wherein pressure sensitive adhesive having the nature to be hardened by light irradiation and reticulated three dimensionary, is provided on a sustaining body having light transmission property.

CONSTITUTION: As for sustaining bodies having light transmissive property, plastic films such as polyvinyl chloride, polyethylene terephthalate, polyethylene, and polypropylene are enumerated. As for pressure sensitive adhesive which is provided on the sustaining body having light transmission property, pressure sensitive adhesive composition is used, in which lower-molecular weight compound having at least double photo- polymerization carbon-carbon double bond in a molecule, and photo-polymerization staring agent are compounded to a pressure sensitive adhesive of, for instance, rubbery or aclylic type. After wafer is cut, securing wafer to the wafer fixing metal sheet, when pressure sensitive adhesive layer is hardened and reticulated three dimensionary by light irradiation from the supporting body side of adhesive metal sheet, since the adhesivity is almost lost, the adhesive to the small piece of element of the adhesive metal sheet is largely lowered, and the pick up can be easily carried out even if the size of the small piece of element is above 50mm.<2>.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

· ⑱ 日本 国特 許 庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-196956

(3) Int Cl. 4 H 01 L 21/78 識別記号

庁内整理番号 A-7131-5F

❷公開 昭和60年(1985)10月5日

審査請求 有

発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

半導体ウェハ固定用接着薄板

②特 顧 昭59-47743

❷出 願 昭59(1984)3月12日

② 発明者 植村 ② 発明者 単田

剛 正 良 成 茨木市下穂積1丁目1番2号 茨木市下穂積1丁目1番2号

日東電気工業株式会社内日東電気工業株式会社内

砂発 明 者

中 及 学

茨木市下穂積1丁目1番2号

日東電気工業株式会社内

の出願人 日東電気工業株式会社

茨木市下穂積1丁目1番2号

砂代 理 人

弁理士 袮宜元 邦夫

月 和

1.発明の名称

半導体ウェハ固定用接着遊板

2.特許請求の範囲

(1)半導体ウェハを来子小片に切断分離する際の 半導体ウェハ固定用の接着薄板であって、光透過 性の支持体とこの支持体上に設けられた光照射に より硬化し三次元網状化する性質を有する感圧性 接着剤屬とからなる半導体ウェハ固定用接着薄板。

(3) 感圧性接着剤層がベースポリマー100 重量部、分子内に光頂合性炭素 - 炭素二重結合を少なくとも2個有する低分子類化合物1~100重量部および光重合開始剤0.1~5 重量部を必須成分として含む感圧性接着剤組成物を支持体上に塗工して設けられた特許請求の範囲第(2) 項記載の半導

体ウェハ固定用接着薄板。

(1) 磁圧性接着剂 間が光照射によりそのゲル分率が55 重量 彩以上でかつ光照射前のゲル分率の1.4 倍以上となる特許請求の範囲 第(3) 項記載の半導体ウェハ固定用接着薄板。

3.発明の詳細な説明

この発明は、半導体ウェハを案子小片に切断分離する際にこのウェハを固定するために用いる半 導体ウェハ固定用接着薄板に関する。

当初、半導体ウェハを素子小片に切断分離する際には、形成すべき素子形状に合わせて半導体ウェハ表面に浅く楔状溝を入れたのち、外力を加えて分割する方法がとられていた。しかし、この方法では分離精度が悪く、しかも切断分離後、素子小片を次のマウント工程へ移すのに人手を要して作業性が低かった。

その後、半導体ウェハを予め接着酶板に貼り付けて固定したのち、このウェハを回転丸刃で案子 形状に沿つて切断し、次いで形成された案子小片 を接着脚板からピックアップすると同時にマウン

特開昭60~196956(2)

トするというダイレクトピックアップ方式がとら れるようになつた。

上記の方法では、回転丸刃を用いての半導体ウエハの切断時に、像燃熱の除去と切断くずの除去と切断に、像燃熱の除去と切断くずの除去と切断にながら水で洗浄する。このため、上記の接着力が必要である。しかし、この接着薄板の接着力が大きすぎると、形成された架子小片の接着薄板からのピックアカが容易でなくなる。このため、接着単板の接着力は、上記の水圧に耐えうる大きさでしかもピックアップの作業性が低下しない程度の大きさとなるように制御されている。

しかしながら、接着砂板の接着力を上記のように制御しうるのは、形成される案子小片が20㎡程度までの大きさの場合であり、近年の集積度の増大したLSI用の菜子小片のように50㎡あるいはそれ以上の大きさのものでは、上記のように接着砂板の接着力を制御することは困難であり、上記のダイレクトピックアップ方式が適用できな

上界してれにともない粘着性をほとんど失うため、接着期板の菜子小片に対する接着力は大幅に低、下する。このため、菜子小片の大きさにはほとんどかかわりなく、つまり菜子小片の大きさが50 耐以上であつてもピックアップを容易に行うことができる。

この発明の半導体ウェハ固定用接着薄板を構成する光透過性の支持体としては、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックフィルムが挙げられる。このフィルムの厚みとしては通常10~100 ~ 程度とするのがよい。

この光透過性の支持体上に設けられた光照射により硬化し三次元網状化する性質を有する感圧性 接着剤圏は、たとえば通常のゴム系あるいはアク リル系の感圧性接着剤に分子中に少なくとも2個 いという問題が生じてきている。 そとで、この発明者らは、案子小片の大きさが

50 域以上となる場合にも使用できる接着薄板を 提供することを目的として検討した結果、この発明をなすに至った。

すなわち、この発明は、半導体ウェハを案子小 片に切断分離する際の半導体ウェハ固定用の接着 海板であつて、光透過性の支持体とこの支持体上 に設けられた光照射により硬化し三次元網状化す る性質を有する感圧性接着剤脳とからなる半導体 ウェハ固定用接着薄板に係るものである。

この発明の半導体ウェハ固定用接着期板によれば、この接着時板の接着力をウェハ切断後のピックアップの作業性を考慮せずに充分な大きさとすることができるため、ウェハの切断時にはこの接着 では素子小片と強固に接着して、洗浄水の水圧が加えられても素子小片が脱落することがない。

一方、ウエハ切断後は、接着薄板の支持体側から光照射し感圧性接着剤層を硬化させて三次元網 状化させることにより、この接着剤層は凝集力が

の光頂合性炭素 - 炭素二重結合を有する低分子型 化合物(以下、光重合性化合物という)および光 重合開始剤が配合されてなる感圧性接着剤組成物 を用いて形成される。

上記のゴム系あるいはアクリル系の感圧性接着 剤は、天然ゴム、各型の合成ゴムなどのゴム系ポ リマーあるいはポリ (メタ)アクリル酸アルキルエステル ステル、 (メタ)アクリル酸アルキルエステルとこれ た共重合可能な他の不飽和単盤体との共重合物 などのアクリル系ポリマーをベースポリマーとし 、アルキルエーテル化メラミン化合物の如き架橋 剤などが配合されたものである。なお、上記のベ ースポリマーが分子内に光重合性炭素 – 炭素二重 結合を持つものであつてもよい。

上記の光重合性化合物は、その分子盤が 通 常 10,000以下程度であるのがよく、より好ましく は、光照射による感圧性接着剤層の三次元網状化 が効率よくなされるように、その分子量が5,000 以下でかつ分子内の光重合性炭素-炭素二度結合

特開昭 60-196956 (名)

の数が 2 ~ 6 個のものを用いるのがよい。このようなとくに好ましい光重合性化合物としては、例えばトリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジベンタエリスリトールテトラアクリレート、ジベンタエリスリトールへキサアクリレートなどが挙げられる。また、その他の光重合性化しり、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールなどが挙げられる。

光重合性化合物としては、上記の化合物のうちの1種を単独で用いてもよいし2種以上を併用してもよく、その使用量は、通常上記のベースポリマー100重量部に対して1~100重量部の範囲とするのがよい。この使用量が少なすぎると、 & E 性接着剤圏の光照射による三次元網状化が不充分となり、接着薄板の案子小片に対する接着力

する接着力の低下の程度が小さすぎて好ましくない。また、この使用量が多すぎるとそれに見合う 効果が得られないばかりか、楽子小片の表面にこの光重合開始剤が残留するため好ましくない。なお、必要に応じてこの光重合開始剤とともにトリエチルアミン、テトラエチルペンタアミン、ジメチルアミノエタノールなどのアミン化合物を光重合促進剤として併用してもよい。

上記の各成分が混合されてなる感圧性接着剤組成物を用いて感圧性接着剤層を形成するには、光透過性の支持体上にこの組成物を塗布し、必要に応じて加熱すればよい。このようにして形成される感圧性接着剤層の厚みとしては通常5~40~であるのがよい。

また、この眼圧性接着剤層は、通常 1 0 0 % モジュラス (2 0 ℃) が 1 0 kg / cd以下であるのがよく、また、通常はトルエンド 2 4 時間浸漉して求めたゲル分率が 5 5 単量 % 未満でゲルの膨稠度が 2 0 倍以上であるのがよい。

上記の光透過性の支持体と感圧性接着剤層とか

の低下の趣度が小さすぎて好ましくない。また、 との使用量が多すぎると、感圧性接着剤層の可塑 化が著しく半導体ウェハ切断時に必要な接着力が 得られないため好ましくない。

上記の光重合開始剤としては、例えばイソプロピルベンゾインエーテル、イソブチルベンゾインエーテル、イソブチルベンゾインエーテル、ベンゾフエノン、ミヒラー氏ケトン、クロロチオキサントン、ドデシルチオキサントン、アセトフエノンジエチルケタール、ベンジルジメチルケタール、ローヒドロキシシクロヘキシルフエニルケトン、2ーヒドロキシメチルフエニルプロパンなどが挙げられ、これらのうちの1種を単独であるいは2種以上の混合で使用すればよい。

この光重合開始剤の使用型としては、通常上記のベースポリマー100重量部に対して0.1~5 重量部の範囲とするのがよい。この使用量が少なすぎると、感圧性接着剤層の光照射による三次元網状化が不充分となり、接着薄板の素子小片に対

らなるとの発明の半導体ウェハ固定用接着期板を 用いて半導体ウェハを案子小片に切断分離するに は、まずこの接着期板に半導体ウェハを貼り付け て固定したのち、回転丸刃でこのウェハを素子小 片に切断する。その後、接着薄板の支持体側から 高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプなどにより、 180~460nmの放長の光を通常10~180 秒間程度照射し、次いで素子小片をニードルで突 き上げると共にエアピンセットで吸着するなどの 方法によりピックアップすると同時にマウントす ればよい。

上記の接着薄板の半導体ウェハに対する180 剝離接着力(剝離速度300mm/分)は、光照射前 には通常200~1,0009/20mmであり、上記の 切断時に加えられる通常2kg/cd程度の水圧によ つてもこの接着薄板から案子小片が剝がれ落ちる ことはない。

一方、光照射されると上記の接着期板の感圧性 接着剤層は、光重合性化合物どうしが重合すると ともにベースポリマーにもラジカルが発生してこ

特開昭 60~196956 (5)

外は実施例1と同様にして比較のための半導体ウェハ固定用接着薄板を得た。

試 験 例 1

上記の実施例1~6および比較例で得られた半 導体ウェハ固定用接着薄板に直径5インチの大き さの半導体ウェハを貼り付け、回転丸刃を用いて 50 mlの大きさの素子小片に切断した。この切断 は2 kg / cdの水圧の水で洗浄しながら行ったが、 上記のいずれの接着薄板においても案子小片が剝 がれ落ちることはなかった。

この切断後、接着薄板の支持体側から高圧水銀ランプ(40W/cm)で15cmの距離から20秒間光照射したのち、楽子小片をニードルで突き上げると共にエアピンセットで吸着することによりピックアップした。実施例1~6の接着薄板を用いていた場合はいずれも容易にピックアップでき、しかも感圧性接着剤層の案子小片への移行は全くなかつた。これに対して、比較例の接着薄板を用いていた場合は案子小片がこの薄板に強固に接着したままでピックアップできなかつた。

くゲル分率、ゲルの膨稠度〉

上記の 政圧性接着利組成物をそれぞれ 1 0 0 % モジュラス用試験片の場合と同様にして整工,加熱を行つたのち、 5 0 mm×5 0 0 mmの大きさに切断したものを試験片とした。この試験片をトルエンに 2 4 時間没減してゲル分率とゲルの膨調度を調べた。また、この試験片に試験例 1 と同様の条件で光照射したのち、これをトルエンに 2 4 時間浸渍してゲル分率とゲルの膨調度を調べた。

上記の試験結果を下記の表に示した。なお、下記の表においてA梱は光照射前の測定値を示し、B棚は光照射後の測定値を示す。

	180 剝離接着 (8/20			100% モジュラス (Kg/cd)		ゲル分率 (重量%)		ゲルの影想度(倍)	
<u> </u>		A	В	A	B	A	В	A	В
実	1	350	30	2.0	6 0	50	8 5	25	10
	2	350	7 0.	3. 0	80	50	85	28	12
施	3	300	2 5	4. 0	8 5	50	80	26	8
	4	800	35	0.5	3 0	40	70	20	10
例	5	340	100	1.5	5 0	40	65	30	13
	6	320	120	2. 0	5 5	40	65	35	15
比例	交例	350	800	2.0	3. 0	5 2	5 5	23	20

試験例2

く180 剝離接着力>

上記の実施例1~6 および比較例で得られた半 導体ウェハ固定用接着薄板の半導体ウェハに対す る180 剝離接着力(剝離速度300mm/分)を測 定した。また、上記の接着薄板を半導体ウェハに 貼り付けて支持体側から試験例1と同様の条件で 光照射したのちの上記の接着力を測定した。

く100%モジュラス〉

上記の実施例1~6および比較例で用いた感圧性接着剤組成物をそれぞれ剝離処理を施した50 mの厚みのポリエチレンテレフタレートフイルムの表面に厚みが10mとなるように塗工し、130℃で3分間加熱したのち、50m×50mの大きさに切断し、棒状にまとめることにより断面機が0.5 mdの糸状の試験片を得た。この試験片について20℃における100%モジュラスを測定した。また、この試験片に試験例1と同様の条件で光照射したのち、同様の100%モジュラスを測定した。

上記の結果から明らかなように、この発明の半 等体ウェハ固定用接着薄板を用いれば、半導体ウ ェハの案子小片への切断時には、上記の接着薄板 と案子小片とが強固に接着しており素子小片が剝 がれ落ちることがなく、しかもウェハ切断後には 、上記の接着薄板の支持体側から光照射すること により架子小片の大きさが50 型以上であつても ピックアップを容易に行うことができる。

また、このように素子小片のピックアップを容易に行えるのは、上記の接着薄板の感圧接着剤層が光照射により三次元網状化して凝集力が著しく上昇するのにともない素子小片に対する接着力が大幅に低下するためであることがわかる。

特許出願人 日東電気工業株式会社代理 人 弁理士 袮 宜元 邦 夫

特開昭60-196956(4)

のポリマーと光虹合性化合物とが反応することに より、接着剤層は硬化し三次元額状化する。

なお、ことでいう三次元網状化とは、通常、接 **着剤層をトルエンに24時間浸漬して求めたゲル** 分率が光照射前の約1.4倍以上となり、かつこの ゲル分率が55 宜量多以上となることを意味する。 また、光照射後の上記の接着剤層は、上記と同様 にして求めたゲルの膨稠度が通常18倍以下とな るのがよい。

剤層の凝集力は光照射前に比べて著しく上昇し、 通常100%モジュラス(20℃)が20Kg/cd以 上となる。てれにともないての接着剤層の粘着性 はほとんど失われて、接着薄板の素子小片に対す る接着力は大幅に低下し、このときの180 剝離 接稽力(剝離速度300m/分)は通常1508/ 20㎜以下となる。このため、紫子小片の大きさ が50 叫以上であつても、接着薄板からの素子小 片のピックアップを容易に行うことができる。

以下にこの発明の実施例を配載する。なお、以

同じもの)5部、ペンタエリスリトールトリアク リレート20部およびイソブチルペンゾインエー テル 0.5 部を添加し混合して感圧性接着剤組成物 を脚裂した。この組成物を用いて実施例1と同様 にしてとの発明の半導体ウェハ固定用接着離板を 得た。

実施例3

アクリル系共取合物(実施例1と同じもの)1 00部にポリイソシアネート化合物(実施例1と 同じもの)5部、ジペンタエリスリトールモノヒ ドロキシペンタアクリレート10部、ジメチルチ オキサントン1 部およびトリエチルアミン1 部を 添加し混合して感圧性接着剤組成物を調製した。 この組成物を用いて実施例1と同様にしてこの発 明の半導体ウェハ固定用接着薄板を得た。

実施例4

アクリル酸プチル100部とアクリル酸 7.5 部 とからなる配合組成物をトルエン中で共重合させ、 て、数平均分子量300000アクリル系共重合 物を得た。

下において部とあるのは重盛部を意味する。

. 実施例1

アクリル酸プチル100部、アクリロニトリル 5 部およびアクリル酸 5 部からなる配合組成物を トルエン中で共取合させて、数平均分子盤 300. 000のアクリル系共重合物を得た。

この共重合物100部にポリイソシアネート化 合物(日本ポリウレタン社製商品名コロネートL) 5部、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペ ンタアクリレート 15 部およびα-ヒドロキシシ クロヘキシルフエニルケトン1部を添加し混合し て感圧性接着剤組成物を調製した。

· との組成物を5 0 岬の厚みのポリエチレンテレ フタレートフイルムの片面に接着剤屬の厚みが 1 0 畑となるように塗工し、1.30℃で3分間加熱 してこの発明の半導体ウェハ固定用接着薄板を得 た。

実施例2

アクリル系共重合物(実施例1と同じもの) 1 0 0 部にポリイン♪アネート化合物(実施例1と

共賃合物としてこのアクリル系共賃合物を用い た以外は実施例1と同様にしてこの発明の半導体 ウエハ固定用接着游板を得た。

奥施·例 5

ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタ アクリレート15部のかわりに 1・6-ヘキサンジ オールジアクリレート40部を用いた以外は実施 例1と同様にしてとの発明の半導体ウェハ固定用 接着蹲板を得た。

寒旅贸6

ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタ アクリレート 15 部のかわりに多官能オリゴエス テルアクリレート(東亜合成化学工業社製商品名 アロニックスM-8030)50部を用いた以外は 実施例1と同様にしてこの発明の半導体ウェハ周 定用接着薄板を得た。

比較例...

ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタ アクリレート15部およびローヒドロキシシクロ ヘキシルフェニルケトン 1 部を使用しなかつた以

4.55

10 mars 18 m

特開昭60-196956 (6)

手統 補正 曹

昭和60年 4月24日

特許庁長官閥

1. 単件の表示

圃

特 騈 昭 59- 47743号

2. 発明の名称

半導体ウエハ固定用接着薄板

3. 棚正をする者

平井との関係 特許出願人

t 所 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

代表者 土 方 三 郎

4. 代 理 人

郵便報号 530

^{性 所} 大阪市北区西天満4丁目9番8号 (第三西宝ピル別館)

E 名 弁理士 (7915) 祢宜元 邦夫 夏廷 大區 (06)363-0641番

5. 補正命令の日付

自発的

60. 4.25

6. 細正の対象

明細書の「発明の味

7. 補正の内容

- A. 明知書:
- (I) 第7頁第3行目:

「トリメチロールプロパントリアクリレート、」とあるを削除いたします。

(2) 第7頁第10~11行目;

「1・4 ープチレングリコールジアクリレート」とあるを「1・4 ~ ブタンジオールジアクリレート」と訂正いたします。

(3) 第16頁下から第3行目;

「また、この試験片に」とあるを「また、これとは別に 5 0 ma× 5 0 maの大きさに切断し、」と訂正いたします。

(4) 第17頁第7行目;

「また、この試験片に」とあるを「また、 これとは別に 5 0 mx × 5 0 0 mmの大きさに切 断し、」と訂正いたします。

特許出願人 日東電気工築株式会社 代理 人 弁理士 祢宜元 邦夫

The Control of the Co